

**特点:**

- 频率: 30~40GHz
- 输出功率: 33dB@Pin=20dBm
- 增益: 18dB
- 工作温度: -55~+85℃
- 芯片尺寸: 2.79×2.315×0.1mm

**性能参数: (TA=+25℃, VD=+6V, IDq=1050mA)**

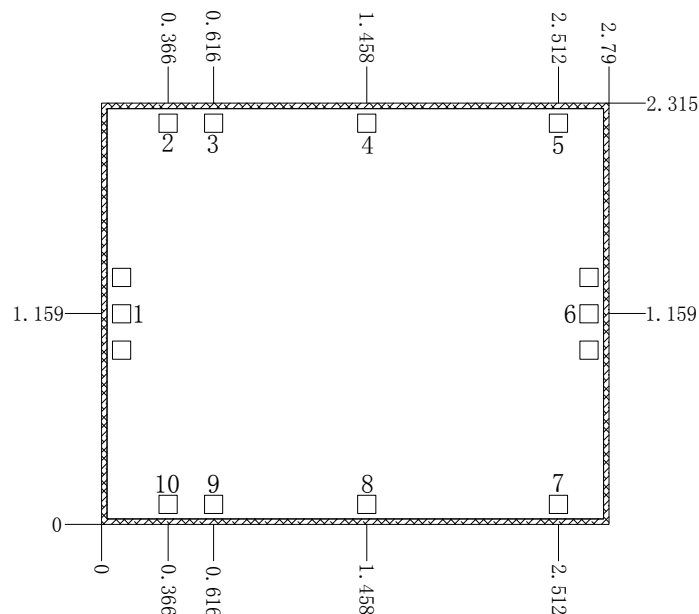
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	VD=+6.0V Zin=Zout=50Ω	30		40	GHz	
增益	G		15	18		dB	
输出功率	Psat			33		dBm	
输入驻波	VSWRi			1.9	6		
输出驻波	VSWRo			2.6	4		
电压	VD			6		V	
静态电流	IDq	VD=+6.0V		1050		mA	
动态电流	ID	VD=+6.0V		1750		mA	

**极限参数表:**

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
最大输入电压	+8	V	最大输入功率	+24	dBm
最大栅压	0	V	贮存温度	-55~+150	

**芯片尺寸图:**

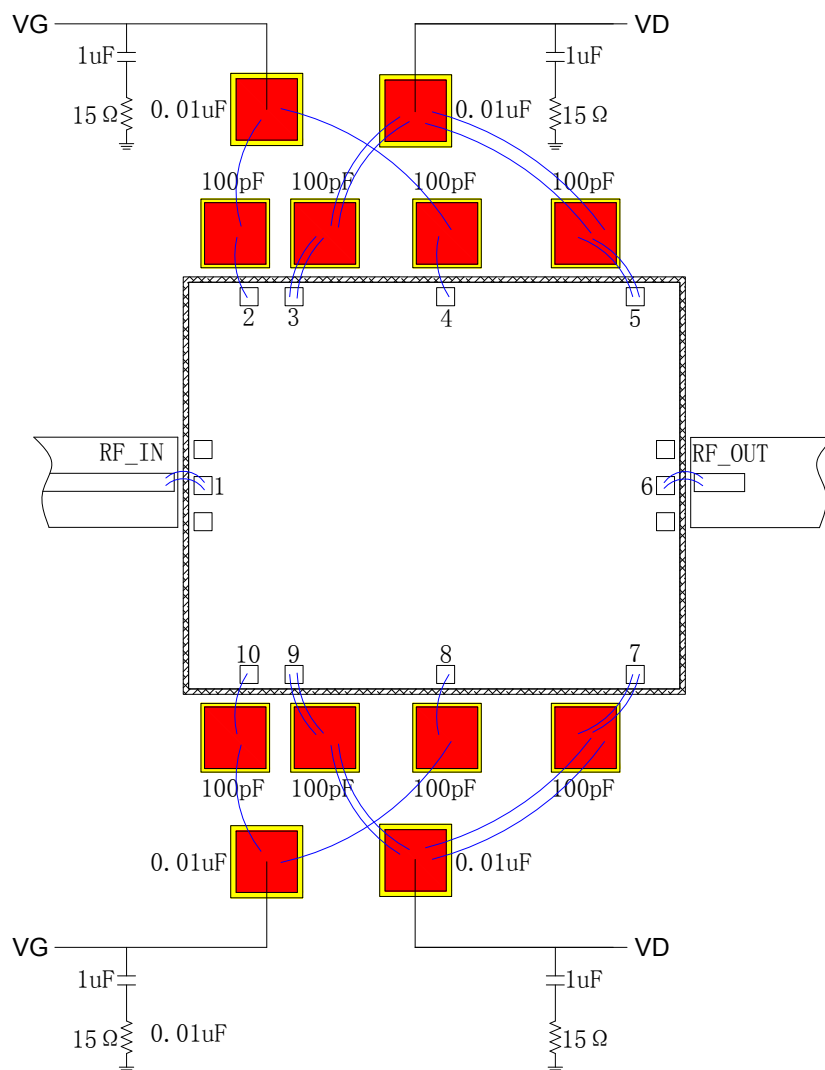
单位: mm



注: 典型键合焊盘尺寸为 100\*100um

**引脚定义:**

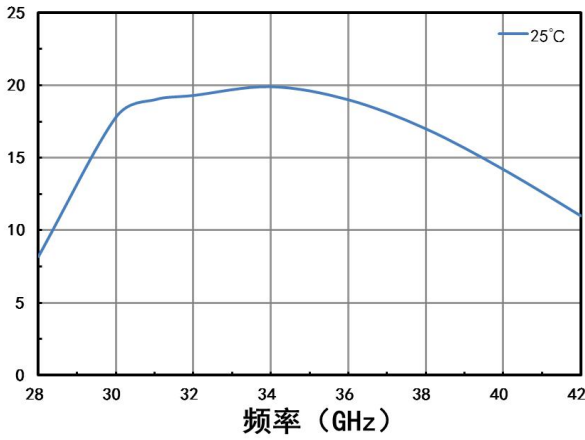
引脚	定义	描述
1	IN	射频输入, AC 耦合
2, 4, 8, 10	VG	放大器栅极电压, 需外接 100pF 和 0.01uF 旁路电容
3, 5, 7, 9	VD	放大器电源电压, 需外接 100pF 和 0.01uF 旁路电容
6	OUT	射频输出, AC 耦合
芯片背面	GND	芯片背面必须接至 RF/DC 地

**推荐装配图:**


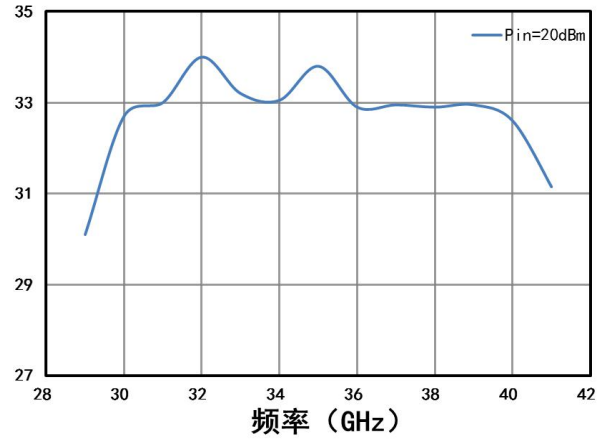
注: 未标注的键合焊盘不需要连接

典型测试曲线:

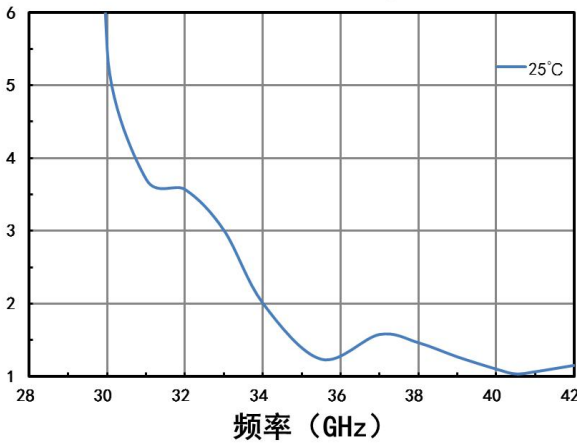
增益 (dB) @ $V_{Ds}=6V$ ,  $I_{Dq}=1050mA$



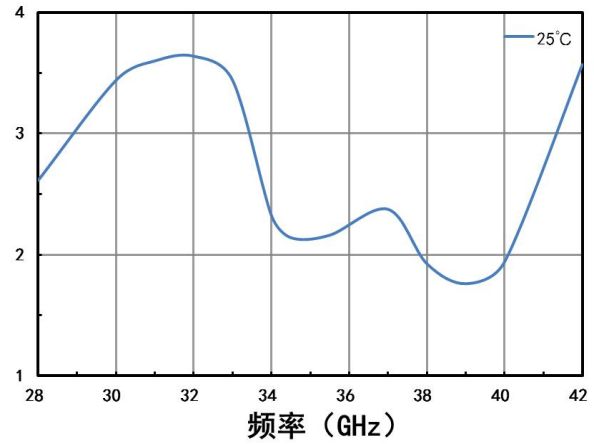
输出功率 (dBm) @ $V_{Ds}=6V$ ,  $I_{Dq}=1050mA$



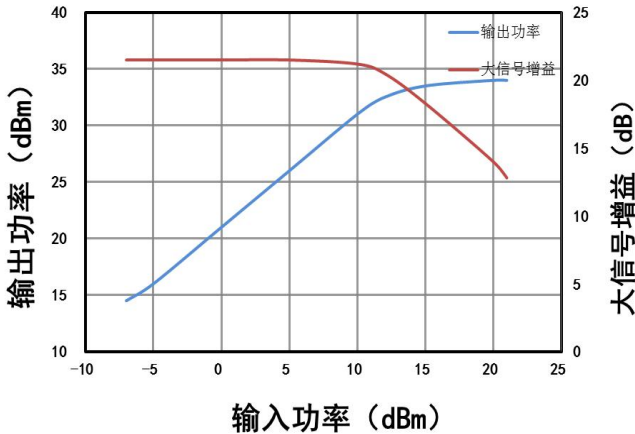
输入驻波比@ $V_{Ds}=6V$ ,  $I_{Dq}=1050mA$



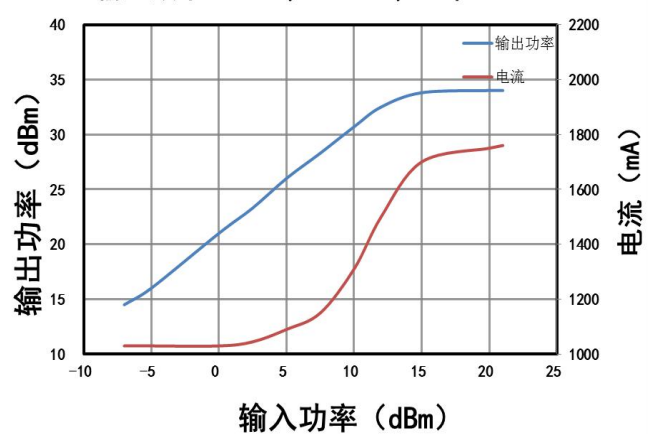
输出驻波比@ $V_{Ds}=6V$ ,  $I_{Dq}=1050mA$



输入频率=35GHz,  $V_{Ds}=6V$ ,  $I_{Dq}=1050mA$



输入频率=35GHz,  $V_{Ds}=6V$ ,  $I_{Dq}=1050mA$



### 产品使用注意事项：

- 1.本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用；
- 2.裸芯片使用的 GaAs 材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心；
- 3.芯片底部用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 295℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
- 4.芯片微波端口与微带线间距不超过 3 mil，使用 1 mil 双金丝键合，其他端口使用 1 mil 单金丝，建议金丝长度 10~16 mil；
- 5.产品对静电敏感，在存储和使用过程中注意防静电；
6. 其他使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。